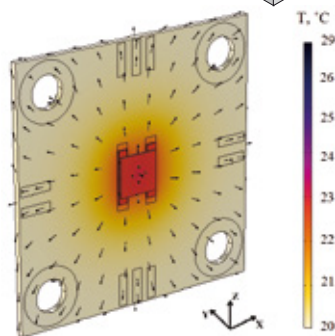
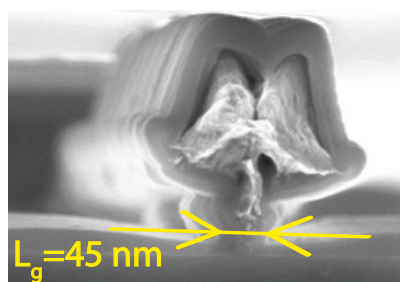
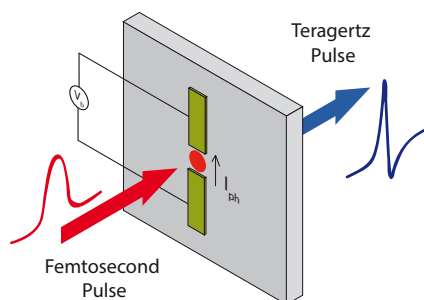
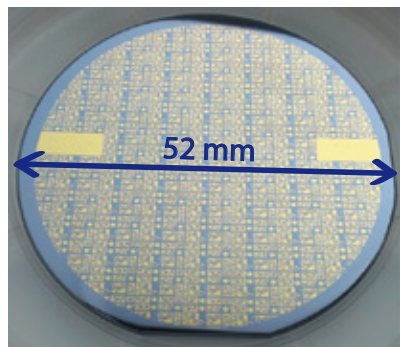


Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники Российской академии наук объявляет набор в аспирантуру на **2017-2018** учебный год по направлению подготовки **11.06.01 – Электроника, радиотехника и системы связи**



Наш институт является признанным лидером в России в области создания материалов и устройств СВЧ и ТГц диапазона частот. Мы приглашаем молодых и амбициозных ученых для решения фундаментальных и прикладных задач в рамках данных направлений исследований. Мы сотрудничаем с ведущими научными центрами: Университеты Тохоку и Айзу (Япония), Политехнический институт Ренсселера (США), СПб АУ РАН, ИПФ РАН, МИРЭА и ФТИАН.

Требования к аспиранту:

1. Активное участие в научных исследованиях, проводимых ИСВЧПЭ РАН.
2. Анализ литературы и написание публикаций в рейтинговых журналах в рамках приоритетных направлений исследований ИСВЧПЭ РАН.
3. Знание алгоритмов моделирования методом Монте-Карло, а также навыки работы в программных платформах COMSOL Multiphysics, CST Microwave Studio и ANSYS HFSS приветствуется.

Прием заявлений и документов для поступления в аспирантуру проводится в период с **01 июля по 31 августа 2017 г.**

Для иногородних аспирантов мы бесплатно предоставляем общежитие в транспортной доступности от ИСВЧПЭ РАН – рядом с м. Академическая.

Контакты:

117105, Москва, Нагорный проезд, д. 7, стр.5

Тел.: 8 (499) 280-74-81

e-mail: mail@isvch.ru, glinский.igor@yandex.ru

Контактное лицо: Глинский Игорь Андреевич

